

AF117 Datasheet, Equivalent, Cross Reference Search

Type Designator: AF117

Material of Transistor: Ge

Polarity: PNP

Maximum Collector Power Dissipation (P_c): 0.075 W

Maximum Collector-Base Voltage $|V_{cb}|$: 32 V

Maximum Collector-Emitter Voltage $|V_{ce}|$: 15 V

Maximum Emitter-Base Voltage $|V_{eb}|$: 2 V

Maximum Collector Current $|I_c \text{ max}|$: 0.01 A

Max. Operating Junction Temperature (T_j): 75 °C

Transition Frequency (f_t): 75 MHz

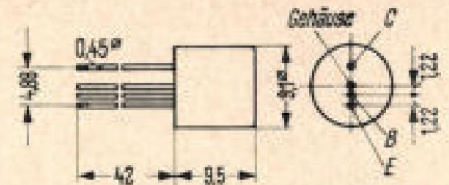
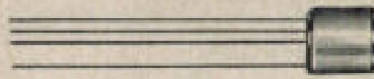
Collector Capacitance (C_c): 3 pF

Forward Current Transfer Ratio (h_{FE}), MIN: 50

Noise Figure, dB: -

Package: TO7

AF 117



Gewicht etwa 1,4 g Maße in mm

pnp-Transistor

AF 117 ist ein diffusionslegierter pnp-Germanium-Hochfrequenz-Transistor mit dem Normgehäuse TO-7. Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert.

Der Transistor AF 117 ist für die Verwendung in Vor- und Mischstufen im M- und L-Bereich und ZF-Verstärkern bei AM-Empfängern geeignet.

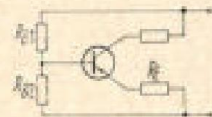
Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
 Kollektor-Basis-Spannung
 Emitter-Basis-Spannung
 Kollektorstrom
 Sperrschichttemperatur
 Gesamtverlustleistung bei $T_U \leq 45^\circ\text{C}$

	AF 117	
$-U_{CE}$	20*	V
$-U_{CB0}$	20	V
$-U_{EB0}$	1	V
$-I_C$	10	mA
T_J	75	$^\circ\text{C}$
P_{tot}	50	mW

* bei $\frac{R_B}{R_E} \leq 100$

$$R_B = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$



Wärmewiderstand

Wärmewiderstand zwischen Kollektorsperrschicht und ruhender umgebender Luft

$$R_{thU} \leq 0,6 \text{ grad/mW}$$

Kenndaten

für eine Umgebungstemperatur von $T_U = 25^\circ\text{C}$

Statische Kenndaten

Für folgenden Arbeitspunkt gilt:

$-U_{CB}$ V	$-I_C$ mA	$-I_B$ μA	B	$-U_{BE}$ V
6	1	7	140	0,27 (< 0,33)

Reststrom

Kollektor-Basis-Reststrom bei $-U_{CB0} = 6 \text{ V}$

$$-I_{CB0} = 1,2 (< 8) \mu\text{A}$$